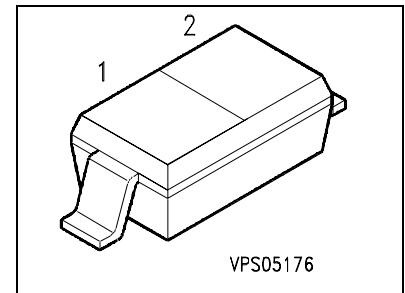


Silicon PIN Diode

- PIN diode for high speed switching of RF signals
- Low forward resistance
- Very low capacitance
- For frequencies up to 3 GHz



Type	Marking	Ordering Code (tape and reel)	Pin Configuration			Package ¹⁾
			1		2	
BAR 63-03W	G	Q62702-A1025	A		C	SOD-323

Maximum Ratings

Parameter	Symbol	BAR 63-03W	Unit
Reverse voltage	V_R	50	V
Forward current	I_F	100	mA
Total Power dissipation $T_S \leq 111^\circ\text{C}$	P_{tot}	250	mW
Operating temperature range	T_{op}	-55 +150°C	°C
Storage temperature range	T_{stg}	-55...+150°C	°C

Thermal Resistance

Junction-ambient ¹⁾	$R_{\text{th JA}}$	≤ 235	K/W
Junction-soldering point	$R_{\text{th JS}}$	≤ 155	K/W

¹⁾Package mounted on alumina 15mm x 16.7mm x 0.7mm

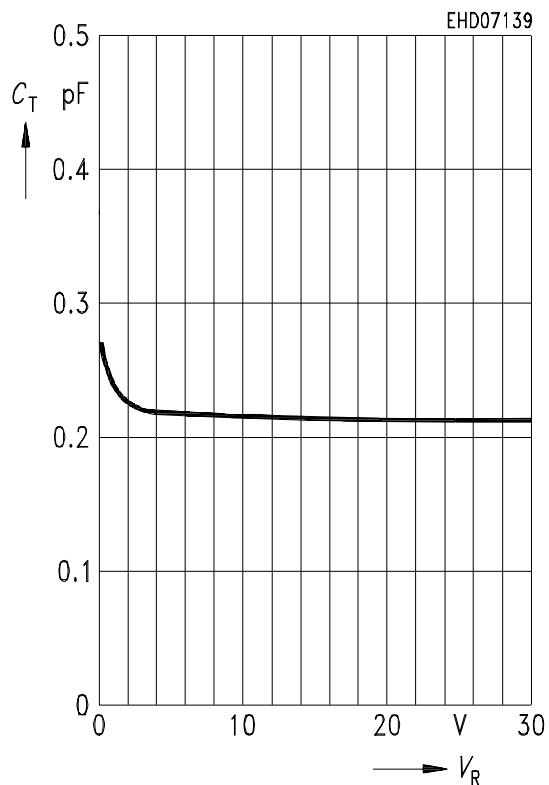
Electrical Characteristics

 at $T_A = 25\text{ °C}$, unless otherwise specified.

Parameter	Symbol	Value			Unit
		min.	typ.	max.	
DC Characteristics					
Breakdown voltage $I_R = 5\text{ }\mu\text{A}$	$V_{(BR)}$	50	-	-	V
Reverse leakage $V_R = 20\text{ V}$	I_R	-	-	50	nA
Forward voltage $I_F = 100\text{ mA}$	V_F	-	0.95	1.2	V
Diode capacitance $V_R = 0\text{ V}$, $f = 100\text{ MHz}$	C_T	-	0.3	-	pF
Diode capacitance $V_R = 5\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$	C_T	-	0.21	0.3	pF
Forward resistance $I_F = 5\text{ mA}$, $f = 100\text{ MHz}$ $I_F = 10\text{ mA}$, $f = 100\text{ MHz}$	r_f	- -	1.2 1	2 -	Ω
Charge carrier lifetime $I_F = 10\text{ mA}$, $I_R = 6\text{ mA}$, $I_R = 3\text{ mA}$	τ_L	-	75	-	ns
Series inductance	L_S	-	2.0	-	nH

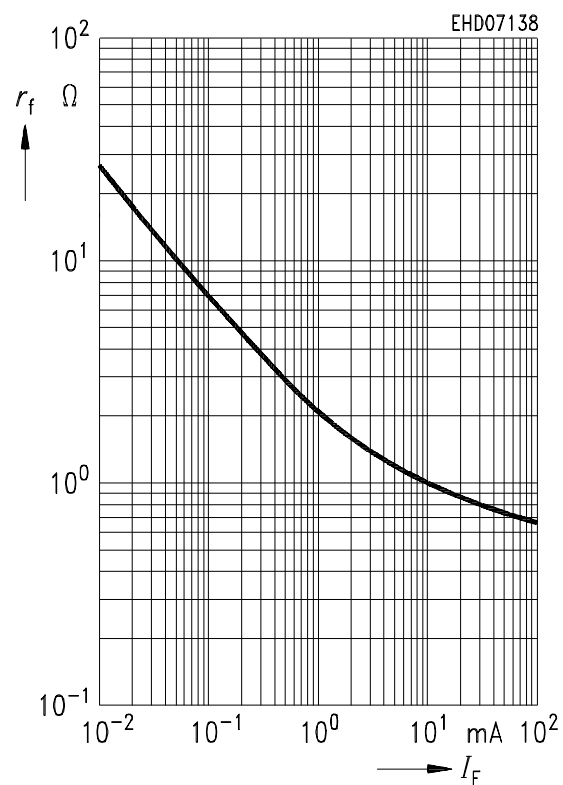
Diode capacitance $C_T = f(V_R)$

$f = 1 \text{ MHz}$

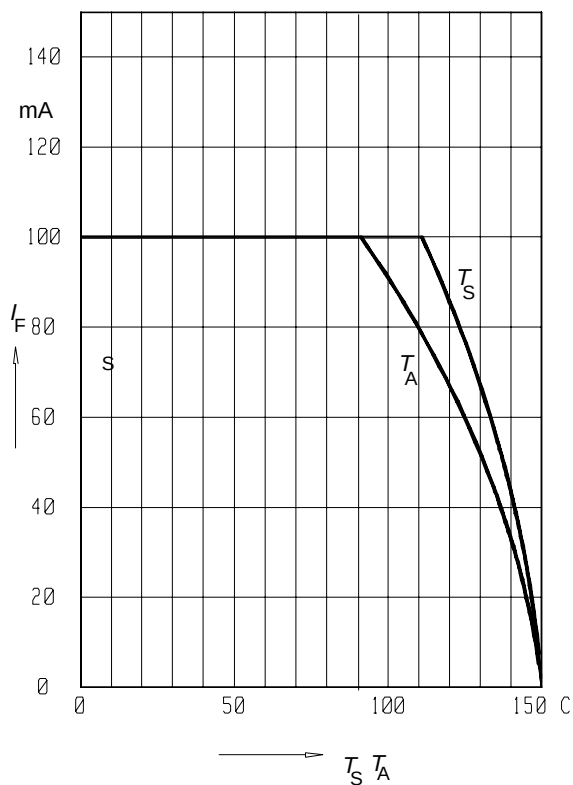


Forward resistance $r_f = f(I_F)$

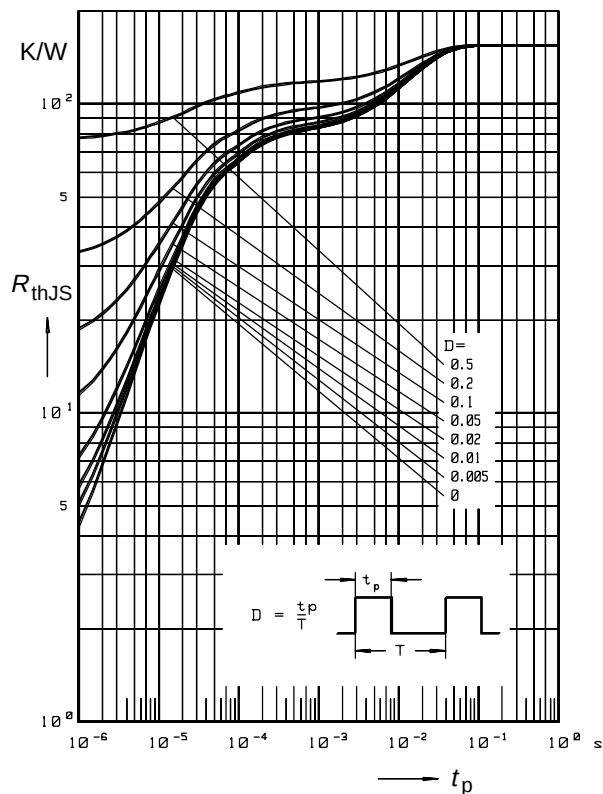
$f = 100 \text{ MHz}$



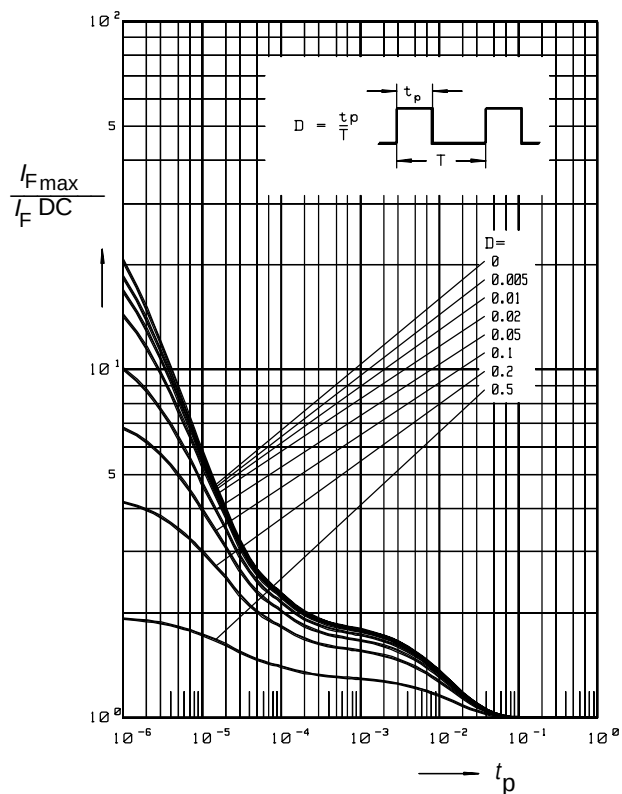
Forward current $I_F = f(T_A, T_S)$



Permissible load $R_{thJS} = f(t_p)$



Permissible load $I_{Fmax} / I_{FDC} = f(t_p)$



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9